Аномалии магнитных и магнитоупругих свойств монокристаллов $Sm_{1-x}Sr_xMnO_3$ ($x \sim 0.5$) при фазовых переходах

© Ю.Ф. Попов, А.М. Кадомцева, Г.П. Воробьев, А.А. Мухин*, В.Ю. Иванов*, К.И. Камилов, Я.С. Штофич, А.М. Балбашов**

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

* Институт общей физики Российской академии наук,

** Московский энергетический институт,

111250 Москва, Россия

E-mail: kadomts@plms.msu.ru

(Поступила в Редакцию 12 ноября 2003 г.)

На основе измерения магнитных и магнитоупругих свойств установлено, что при понижении температуры в монокристаллах $\text{Sm}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ (x = 0.5 и 0.55) при $T_{co} = 220$ К происходит спонтанный фазовый переход из парамагнитного в локальное зарядовое упорядоченное состояние, а при $T_N = 175$ К в антиферромагнитное состояние *A*-типа. Показано, что сильные магнитные поля ($H_{cr} \sim 200$ kOe) разрушают антиферромагнитный порядок и зарядовое упорядочение и индуцируют фазовый переход в проводящее ферромагнитное состояние. Построены фазовые H-T-диаграммы для монокристаллов с x = 0.5 и 0.55.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 03-02-16445а).

1. Введение

Исследованию замещенных манганитов R_{1-r}M_rMnO₃ (R = La, Pr, Nd, Sm; M = Ca, Sr) в последнее десятилетие посвящено большое число работ, что в значительной степени объясняется обнаружением в этих соединениях в определенном концентрационном интервале эффекта колоссального магнитосопротивления [1,2]. Замечательной особенностью замещенных манганитов является также сильная корреляция спинзарядово-решеточных степеней свободы и наличие богатых фазовых Т-х-диаграмм. Фазовые диаграммы существенно различаются в зависимости от типа редкоземельного иона. По мере уменьшения толеранс-фактора с увеличением атомного номера R и перехода от Sr к Са происходит уменьшение ширины зоны, что ведет к усилению эффектов локализации и переходу от ферромагнитного к антиферромагнитному и зарядовому упорядочениям.

Среди разнообразных замещенных манганитов R_{1-x}M_xMnO₃ особый интерес представляют соединения с x = 0.5, поскольку именно в них обнаружены состояния с различными типами магнитного, орбитального и зарядового упорядочений. Среди этих соединений наименее изученным является манганит Sm_{0.5}Sr_{0.5}MnO₃, относительно характера упорядочения которого в литературе имеются противоречивые данные. В работе [3], выполненной на поликристаллических образцах, приводится фазовая *T*-*x*-диаграмма, согласно которой состав x = 0.5 обладает локальным зарядовым упорядочением и является ферромагнетиком. В работе [4] приводятся данные измерений монокристалла Sm_{0.5}Sr_{0.5}MnO₃, в котором наблюдается антиферромагнитное упорядочение. С целью устранения имеющихся противоречий нами было предпринято исследование спонтанных и индуцированных сильным магнитным полем фазовых переходов в монокристаллах при x = 0.5 и 0.55. Проведенное исследование магнитных и магнитоупругих свойств показало, что в этих соединениях вопреки данным работы [3] спонтанный магнитный момент отсутствует и существует два спонтанных фазовых перехода: при $T_{co} = 220$ К локальное зарядовое упрядочение и при $T_{N} = 175$ К антиферромагнитное поле (~ 200 kOe) подавлает слабомагнитное низкопроводящее состояние и индуцирует фазовый переход в ферромагнитное проводящее состояние.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Монокристаллы Sm_{1-x}Sr_xMnO₃ (x = 0.5 и 0.55) были выращены методом зонной плавки с радиационным нагревом. Проводились измерения магнитных и магнитоупругих свойств в интервале температур 10–300 К. В слабых магнитных полях магнитная восприимчивость обнаруживает широкий максимум вблизи $T_{co} = 220$ К (рис. 1, *a*) с последующим резким спадом при понижении температуры до $T_{\rm N} = 175$ К. Полагаем, что при $T_{\rm co} = 220$ К в согласии с [3] происходит локальное зарядовое упорядочение, а при $T_{\rm N} = 175$ К в отличие от [3] — антиферромагнитное упорядочение, о чем свидетельствует отсутствие спонтанного момента на кривых M(H) (вставка на рис. 1, *a*). Как видно из рис. 1, *b*, при $T_{\rm N} = 175$ К наблюдается локальный

¹¹⁹⁹⁹² Москва, Россия

¹¹⁷⁹⁴² Москва, Россия



Рис. 1. Температурная зависимость для монокристаллов $\text{Sm}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$: *a* — магнитной восприимчивости, измеренной при H = 5.75 kOe для составов x = 0.5 (*1*) и 0.55 (*2*); *b* — электросопротивления для x = 0.5; *c* — теплового расширения для x = 0.5. На вставке показаны кривые намагниченности при слабых магнитных полях.

максимум в температурной зависимости электросопротивления, тогда как в целом зависимость $\rho(T)$ носит полупроводниковый характер, типичный для манганитов с достаточно большой степенью локализации. Температурная зависимость теплового расширения также имела аномалию при $T_{\rm N} = 175$ К (рис. 1, *c*), а при $T_{\rm co} = 220$ К аномалия не наблюдалась, по-видимому, из-за локального характера зарядового упорядочения [3]. Предполагаем, что антиферромагнитная структура Sm_{0.5}Sr_{0.5}MnO₃ является структурой *А*-типа, т.е. состоит из ферромагнитных слоев с антиферромагнитным взаимодействием между слоями.

При измерении кривых намагничивания в сильном магнитном поле наблюдалось возрастание намагниченности, которое имело скачкообразный характер при

 $T \leq T_{\rm N} = 175 \,{\rm K}$ и размытый характер в интервале температур 175 < T < 220 K. Сильный рост намагниченности при пороговых полях H_{cr} при T < $T_{\rm N}$ связан, очевидно, с переходом в ферромагнитное состояние



Рис. 2. Зависимость намагниченности поля при различных температурах для Sm_{0.5}Sr_{0.5}MnO₃ (*a*) и Sm_{0.45}Sr_{0.55}MnO₃ (*b*).

от магнитного монокристаллов



Рис. 3. Фазовые $H_{cr}(T)$ диаграммы для x = 0.5 и 0.55.



Рис. 4. Зависимость магнитострикции от поля при T = 20 К для составов x = 0.5 и 0.55.

при подавлении антиферромагнитного упорядочения, а в интервале температур 175 < T < 220 К — с подавлением локального зарядового упорядочения, среднюю температуру возникновения которого мы приняли за $T_{\rm co} = 220 \, {\rm K}$. Величина порогового поля для $T = 10 \, {\rm K}$ составляла $H_{cr} = 240$ kOe. Аналогичный характер кривых намагничивания в сильном магнитном поле наблюдается также для состава x = 0.55 (рис. 2, *b*). По значениям пороговых полей, вызывающих фазовый переход в ферромагнитное состояние при разных температурах, были построены фазовые Н-Т-диаграммы для обоих составов (рис. 3). Различие результатов по характеру магнитной структуры Sm_{0.5}Sr_{0.5}MnO₃ для моно- и поликристаллов связано, по-видимому, с лучшей стехиометричностью по кислороду у монокристаллов.

Было также обнаружено, что фазовый переход из антиферромагнитного в ферромагнитное состояние сопровождается магнитострикционной деформацией $\frac{\Delta l}{l} \sim 10^{-3}$. При этом следует отметить, что переход происходит столь резко, что после первого измерения образец частично разрушается и последующие значения магнитострикции оказываются меньше первоначального на порядок величины. Поэтому на рис. 4 величины магнитострикции для обоих составов указаны в относительных единицах. Следует отметить, что магнитострикционные деформации сопровождаются сильным гистерезисом, имеющим сложный характер.

В результате проведенного исследования установлено, что монокристаллы $Sm_{1-x}Sr_xMnO_3$ (x = 0.5 и 0.55) не являются ферромагнетиками, как это было установлено в [3]. Согласно нашим измерениям, в исследуемых составах с понижением температуры обнаруживаются два спонтанных фазовых перехода: при $T_{co} = 220$ К переход в состояние с локальным зарядовым упорядочением и при $T_N = 175$ К переход в чистое антиферромагнитное состояние предположительно *A*-типа. Таким образом, приведенная в работе [3] фазовая T-x-диаграмма для состава вблизи x = 0.5, нуждается, по-видимому, в уточнении. Сильное магнитное поле (~ 200 kOe) подавляет антиферромагнитную и зарядовоупорядоченную фазы и индуцирует фазовый переход в ферромагнитное проводящее состояние.

Список литературы

- [1] Y. Tokura, Y. Tomioka. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1 (1999).
- [2] M.B. Salamon, M. Jaime. Rev. Mod. Phys. 73, 583 (2001).
- [3] C. Martin, A. Maignan, M. Hervieu, B. Raveau. Phys. Rev. B 60, 12191 (1999).
- [4] Y. Tomioka, H. Kuwahara, A. Asamitsu, M. Kasai. Appl. Phys. Lett. 70, 3609 (1997).